

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年1月18日(2007.1.18)

【公開番号】特開2005-136437(P2005-136437A)

【公開日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【年通号数】公開・登録公報2005-020

【出願番号】特願2005-288(P2005-288)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

H 01 L 21/02 (2006.01)

H 01 L 21/677 (2006.01)

H 01 L 21/673 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 8 J

H 01 L 21/304 6 4 2 E

H 01 L 21/304 6 4 7 B

H 01 L 21/304 6 4 7 Z

H 01 L 21/304 6 4 8 L

H 01 L 21/02 D

H 01 L 21/68 A

H 01 L 21/68 V

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月22日(2006.11.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体基板の室温洗浄装置と、洗浄後の半導体基板を処理する処理装置とを、隣接するように配置したことを特徴とする半導体製造システム。

【請求項2】

前記半導体基板の洗浄装置並びに洗浄後の半導体基板を処理する処理装置が、略々プロセス順に配置された請求項1に記載の半導体製造システム。

【請求項3】

フォトリソグラフィ装置及び室温洗浄装置を分散配置することにより、半導体基板の搬送距離を略々最短ならしめたことを特徴とする請求項1又は2に記載の半導体製造システム。

【請求項4】

前記フォトリソグラフィ装置、前記室温洗浄装置及び前記処理装置の間をクリーンN₂あるいはクリーンN₂/O₂雰囲気搬送装置で接続したことを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載の半導体製造システム。

【請求項5】

前記処理装置は、不純物導入装置、酸化・拡散装置、CVD装置、プラズマCVD装置、スピッタ装置、RIE装置のいずれかであることを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の半導体製造システム。